




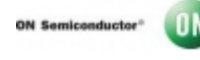


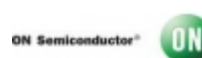

	<h2 style="text-align: center;">FDI038AN06A0</h2>	
	<p>제조업체 부품 번호: FDI038AN06A0</p> <p>제조업체 / 브랜드: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>설명일부: MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB</p> <p>데이터 시트:  FDI038AN06A0.pdf</p> <p>RoHS 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 933 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

부품 번호	FDI038AN06A0
제조사	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
기술	MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	933 pcs Stock
상세 설명 연속	N-Channel 60V 17A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through PowerTrench®
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Through Hole
패키지 / 케이스	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
제조업체 장치 패키지	I ² PAK (TO-262)
전력 소비 (최대)	310W (Tc)
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	60V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	17A (Ta), 80A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	3.8 mOhm @ 80A, 10V
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	124nC @ 10V
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	6400pF @ 25V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	6V, 10V
Vgs (최대)	±20V
포장	Tube
무연 여부 / RoHS 준수 여부	Lead free / RoHS Compliant
수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)

FDI038AN06A0은 재고가있는 새로운 원본이며, FDI038AN06A0 데이터 시트, PDF, 인벤토리를 Y-IC.com 온라인에서 검색하고, 보증 AMI Semiconductor / ON Semiconductor AMI Semiconductor / ON Semiconductor를 주문하십시오. RFQ FDI038AN06A0 : Info@Y-IC.com

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>FDI038AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 265A TO-262</p>	 <p>FDI040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>
 <p>FDI030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI038AN06A0 FAIRCHILD FDI038AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDI045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>

핫 부품

더

# 08055C104J422A	↔ 08055D105KAT2A	⇒ 12101U430JAT2A	D BAT30JFILM	⇒ C1005X7R1H473M050BB
↔ CAT5140ZI-50-GT3-A0	# CS5172GDR8G	D CSPEM1306A	⇒ DM54LS393J	⇒ DT101F12KEC
# ESD12VD9	↔ FDI030N06	# FDI030N06	↔ FDI038AN06A0	⇒ FDI038AN06A0
D FDI040N06	# FDI040N06	↔ FT1500AU-24	# GRM022R71A221MA01L	⇒ GRM1887U1H4R3CZ01D
⇒ HCF4098BMTR	↔ HFA1113IB	# IFS-0524	↔ K9GAG08UOM-PIB0	⇒ LFB182G45SG9A246
↔ LM4132AMFX-3.0	⇒ LM4818MX/NOPB	D LP2989IMM-1.8/NOPB	# LTC3542IS6#TRPBF	↔ LX8415-00CST
# MCP4162-502E/MF	D MIC5302-1.8YMTR	⇒ MMSZ5229B-V-GS08	↔ S-817A32ANB-CUVT2	⇒ SA53779857
↔ SC431LC5SK-1	# SH100U21D	↔ SI4122-D-GMR	⇒ SM3307PSQA-TRG	⇒ SP207EET-L
# SP3495EEN	↔ ST7282B2Q6A/LCH	# STT27GK16B	D TLC3741N	⇒ TPS51727RHAR
↔ VE-JT1-IW	# VI-BN3-CV	↔ VI-JWY-CZ	# VN750PSTR-E	⇒ ZR78L10GTA

Contact us: Info@Y-IC.com

주소 : A5-B5 No.509, 5 / F 노래 공장 건물, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

저작권 © 2019 YIC International Co., Limited